

# 半 导 体 学 报

第 5 卷 第 6 期 1984 年 11 月

## 目 录

- 高掺杂沟道 GaAs M-I ( $10^2\text{\AA}$ )-S Schottky 势垒栅场效应晶体管 (MIS SB FET) ..... 周 勉 王渭源 (577)
- 聚乙烯链中极化子和孤子对形成速率的计算 ..... 顾宗权 王永良 (585)
- 蓝宝石-硅和尖晶石-硅界面层宽度的俄歇分析 .....  
..... 余觉觉 曹大年 王维明 咎育德 邓惠芳 王建华 郁元桓 (596)
- 亚微米厚自支撑单晶 Si 薄膜的沟道-背散射研究 .....  
..... 彭秀峰 龙先灌 王明华 何福庆 郭华聪 (605)
- 微波凹槽栅结构 GaAs FET's 的有限元二维数值分析 ..... 汪正孝 (611)
- 低压化学蒸汽淀积的三维计算机模拟 ..... 王季陶 张世理 王焕杰 连美华 (621)
- AlGaP 固溶体的电反射光谱 ..... 江德生 涂相征 刘继光 (631)
- InGaAsP/InP 双异质结激光器发射的  $0.95\mu\text{m}$  发光带和俄歇复合 .....  
..... 庄蔚华 郑宝真 徐俊英 李玉璋 许继宗 陈培力 (638)
- 氢化的无定形 GaAs 的光吸收及其退火研究 ..... 汪兆平 (646)
- 关于 Cu、Ag、Au 在 Si 和 Ge 表面的吸附 ..... 车静光 张开明 谢希德 (653)
- CVD 法定积  $\text{Al}_2\text{O}_3$  膜及其与 InP、Si 的界面性质 ..... 袁仁宽 徐俊明 (661)
- SOS 膜的铝自掺杂剖面 ..... 陈庆贵 蔡希介 史日华 王其闵 陆东元 (666)

## 研 究 简 报

- 用扩散法向单晶硅中引入稀土元素 Yb 及其若干物理性质的研究 .....  
..... 傅春寅 鲁永令 (671)
- 磷砷化镓离子注入层的 CW  $\text{CO}_2$  激光退火研究 .....  
..... 马景林 周瑞英 李国辉 阎凤章 (676)
- $1.55\mu\text{m}$  掩埋条形 InGaAsP/InP 激光器 .....  
..... 王 圩 张静媛 田慧良及器件工艺组 (679)
- 化合物半导体 AlSb、ZnSe 和 CdTe 的能带结构 .....  
..... 郭志权 范钦梁 黄和鸾 邢金海 (683)
- 掺铈锗中基态能级裂距的作用 ..... 傅绮英 (689)
- 分子束外延选择性掺杂的 GaAs/N-GaAlAs 异质结 .....  
..... 陈宗圭 梁基本 孙殿照 黄运衡 孔梅影 (694)

## 研 究 快 报

- 一种新颖的负阻开关器件——双向负阻晶体管 .....  
..... 李凤银 周 旋 李锦林 曹体伦 (698)